

18A、650V N沟道增强型场效应管

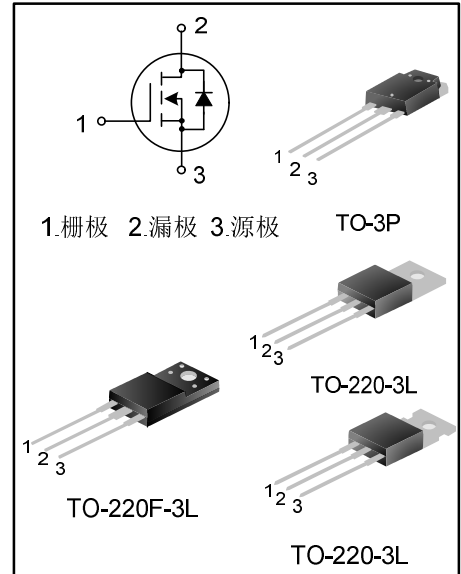
描述

SVF18N65F/T/PN N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管采用士兰微电子的F-Cell™平面高压VDMOS工艺技术制造。先进的工艺及原胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

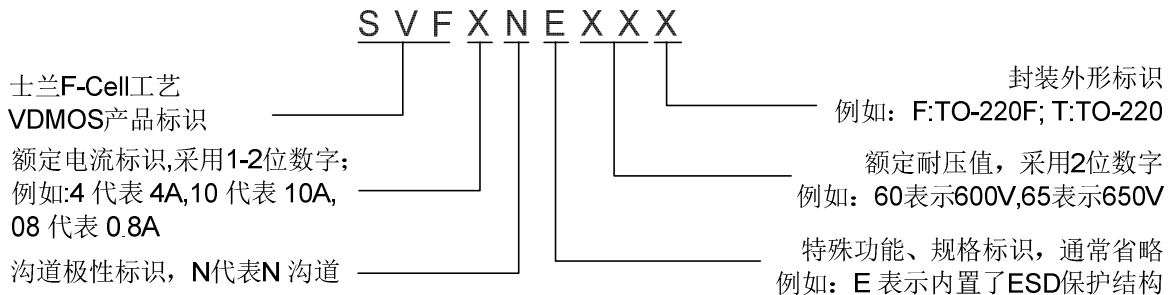
该产品可广泛应用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PWM马达驱动。

特点

- ◆ 18A, 650V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= $0.48\Omega@V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了dv/dt能力



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SVF18N65F	TO-220F-3L	SVF18N65F	无铅	料管
SVF18N65T	TO-220-3L	SVF18N65T	无铅	料管
SVF18N65PN	TO-3P	18N65	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	参数范围			单位
		SVF18N65F	SVF18N65T	SVF18N65PN	
漏源电压	V_{DS}	650			V
栅源电压	V_{GS}	± 30			V
漏极电流	I_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$			A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$			
漏极脉冲电流	I_{DM}	72			A
耗散功率 ($T_C=25^{\circ}\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	54	228	235	W
		0.43	1.82	1.88	
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	1008			mJ
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$			$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$			$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参数名称	符号	参数范围			单位
		SVF18N65F	SVF18N65T	SVF18N65PN	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.31	0.55	0.53	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	50.0	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电性参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	650	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	--	--	± 100	μA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	3.0	--	5.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=9.0\text{A}$	--	0.48	0.55	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V},$ $f=1.0\text{MHz}$	--	2706.3	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	233.3	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	1.8	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=325\text{V}, R_G=25\Omega,$ $I_D=18\text{A}$	--	58.07	--	ns
开启上升时间	t_r		--	90.87	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	58.13	--	
关断下降时间	t_f		(注 2,3)	--	51.20	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=520\text{V}, I_D=18\text{A},$ $V_{GS}=10\text{V}$	--	37.08	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	17.66	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		(注 2,3)	--	8.81	

源-漏二极管特性参数

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS管中源极、漏极构成的反偏P-N结	--	--	18	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	72	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=18.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=18.0A, V_{GS}=0V,$ $dI_F/dt=100A/\mu S$ (Note 2)	--	632.36	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	8.26	--	μC

注：

1. $L=30mH, I_{AS}=8.2A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图1. 输出特性

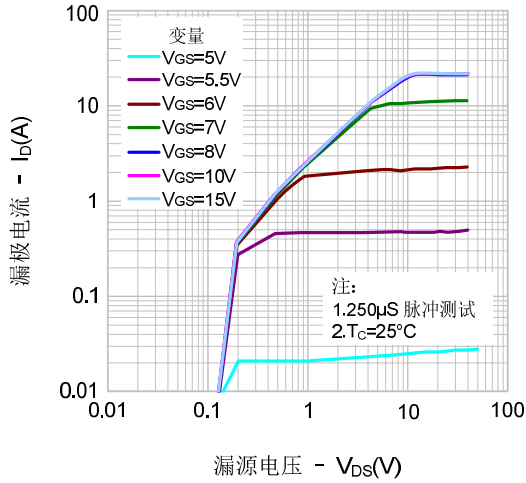


图2. 传输特性

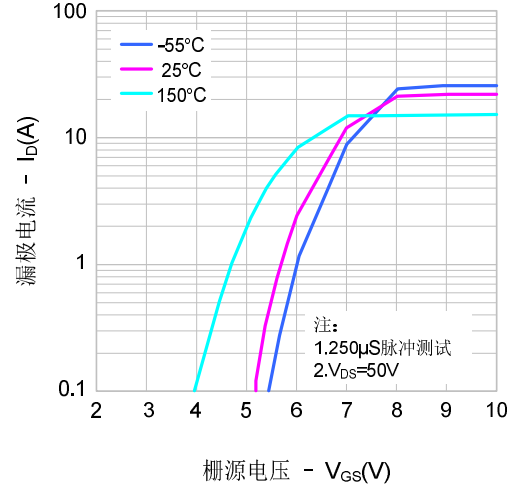


图3. 导通电阻 vs. 漏极电流、栅极电压

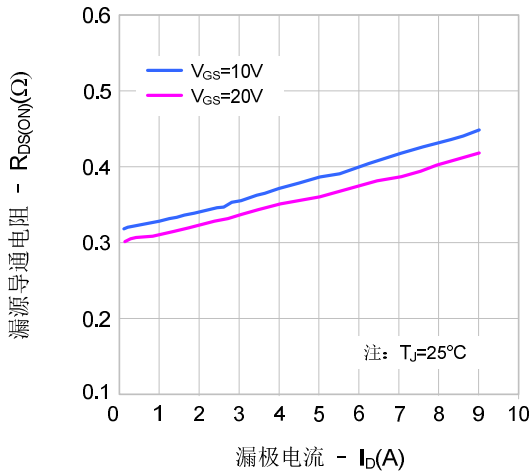


图4. 体二极管正向压降 vs. 源极电流、温度

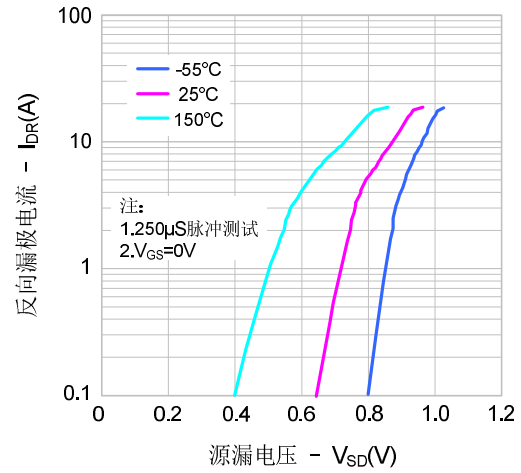


图5. 电容特性

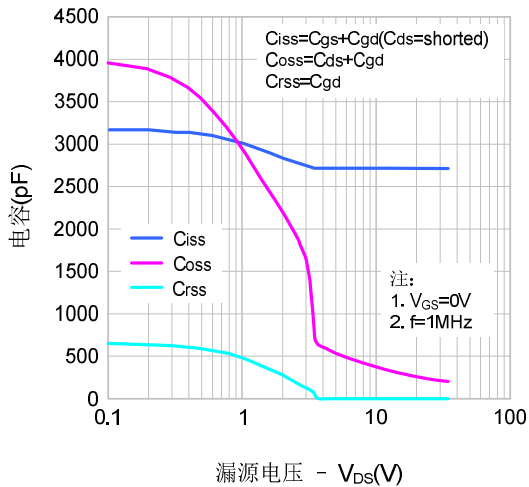
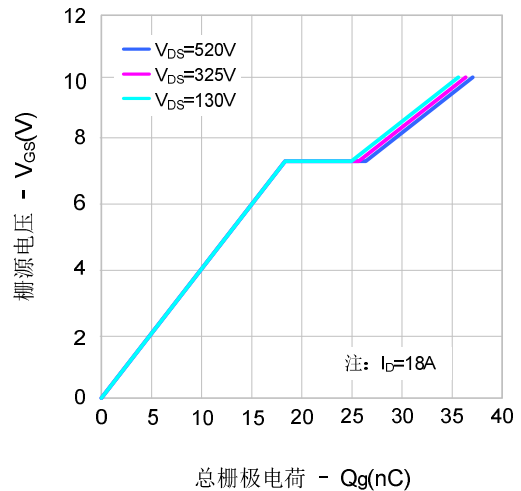


图6. 电荷量特性



典型特性曲线

图7. 击穿电压vs.温度特性

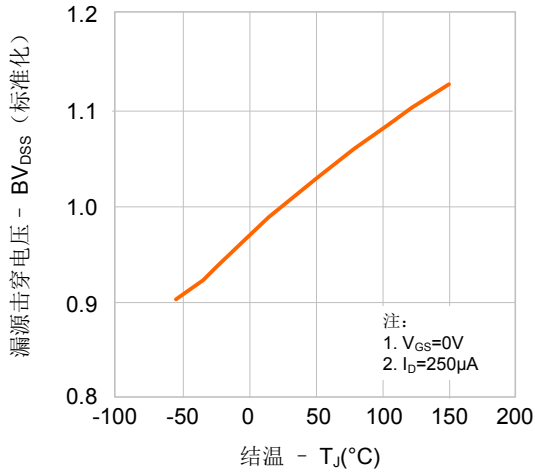


图8. 导通电阻vs.温度特性

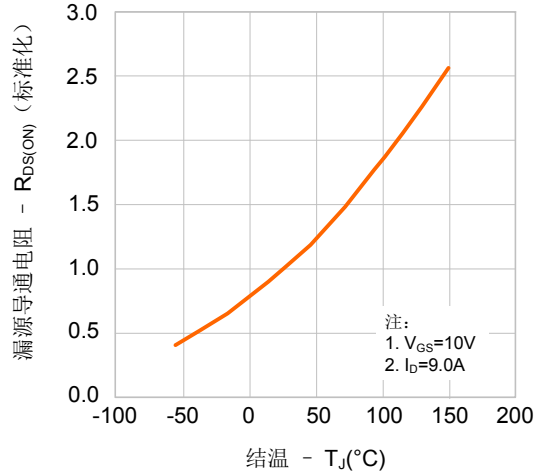


图9-1. 最大安全工作区域(SVF18N65F)

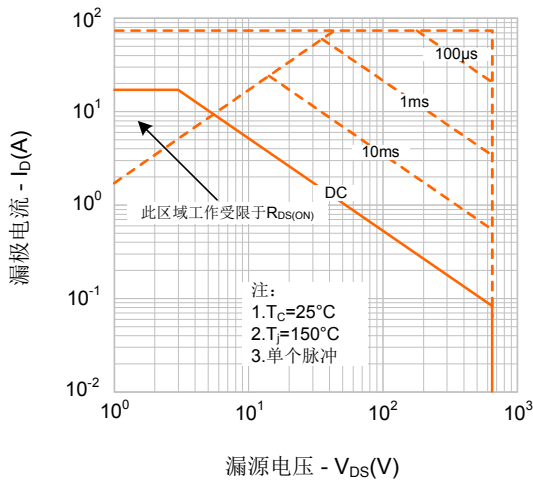


图9-2. 最大安全工作区域(SVF18N65T)

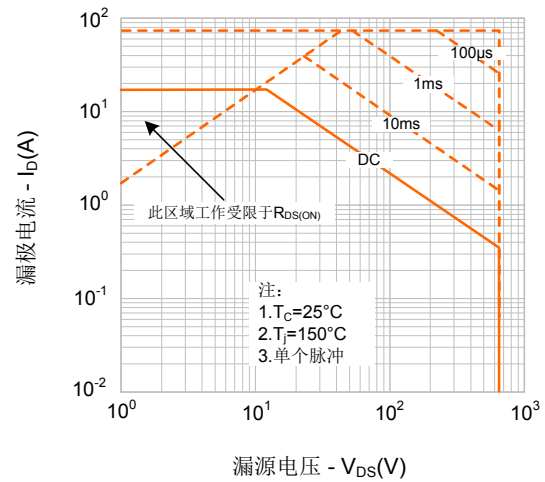


图9-3. 最大安全工作区域(SVF18N65PN)

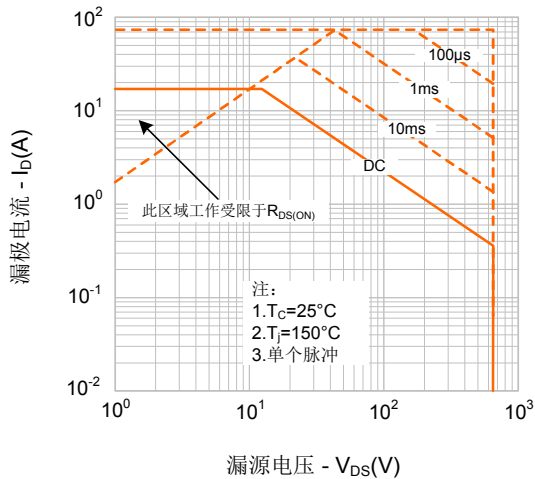
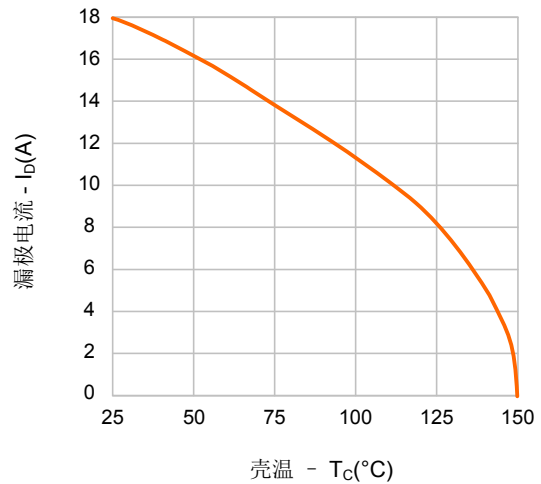
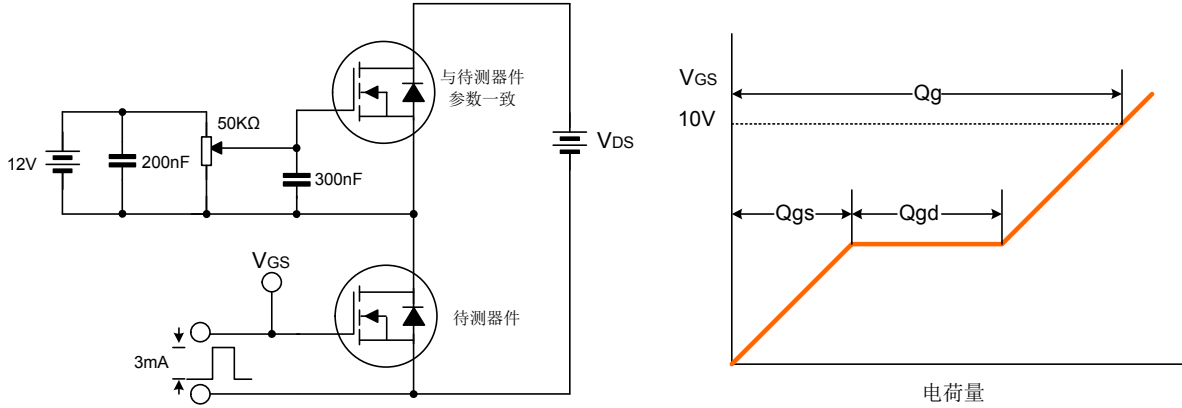


图10. 最大漏电流vs. 壳温

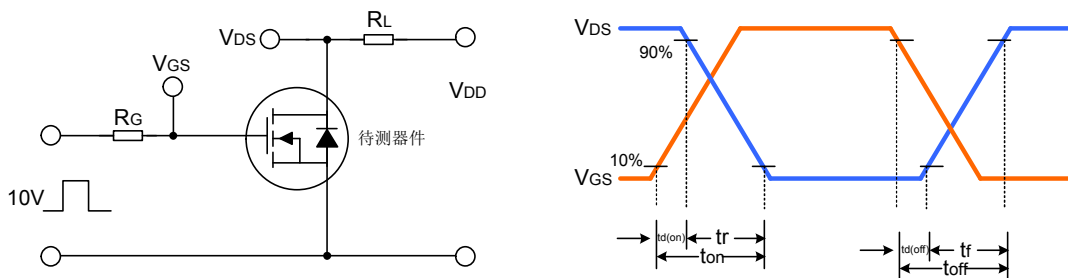


典型测试电路

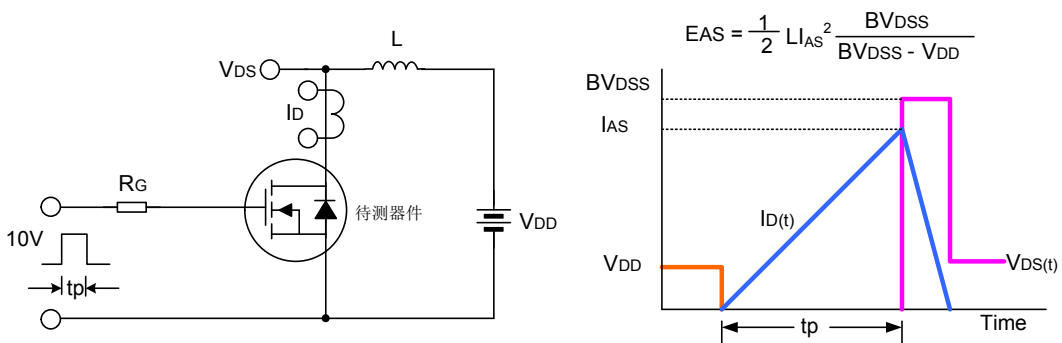
栅极电荷量测试电路及波形图



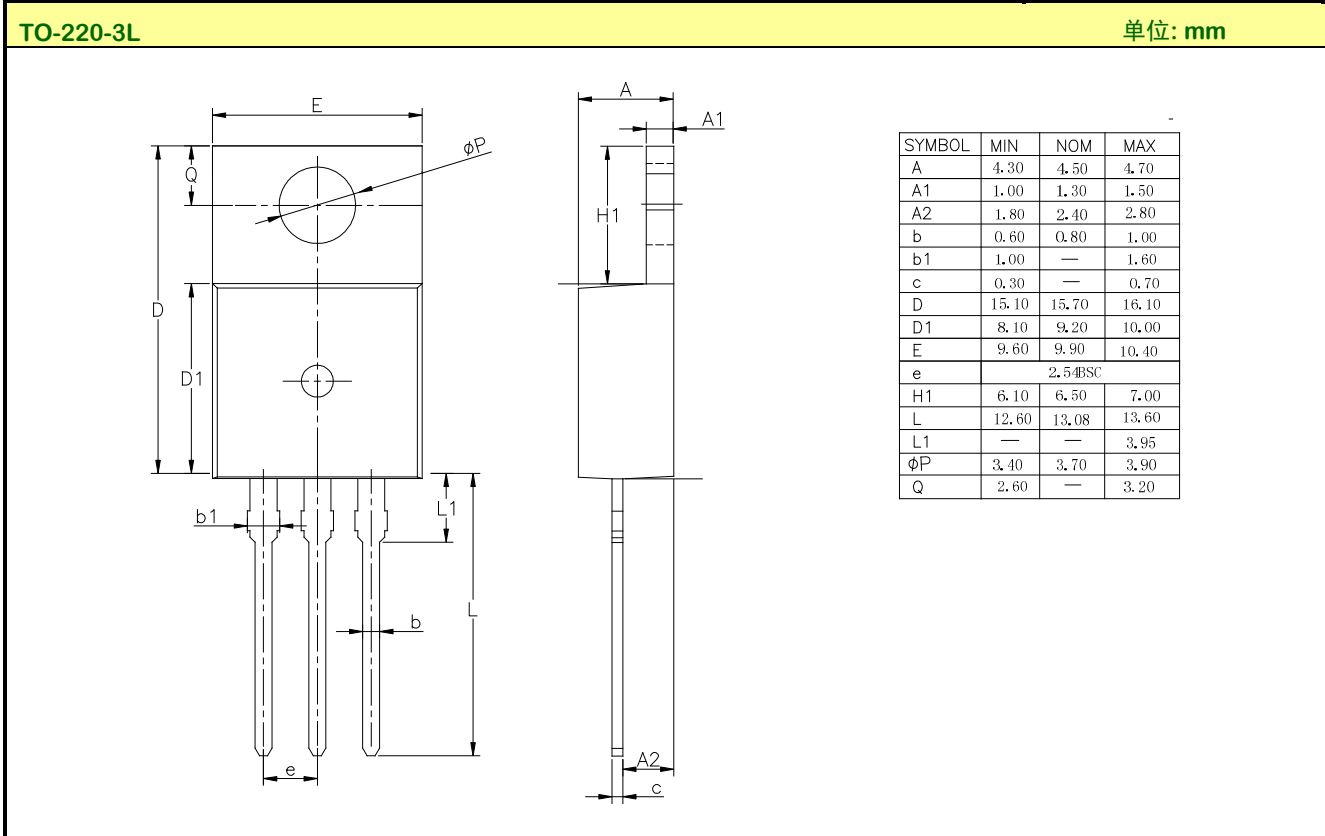
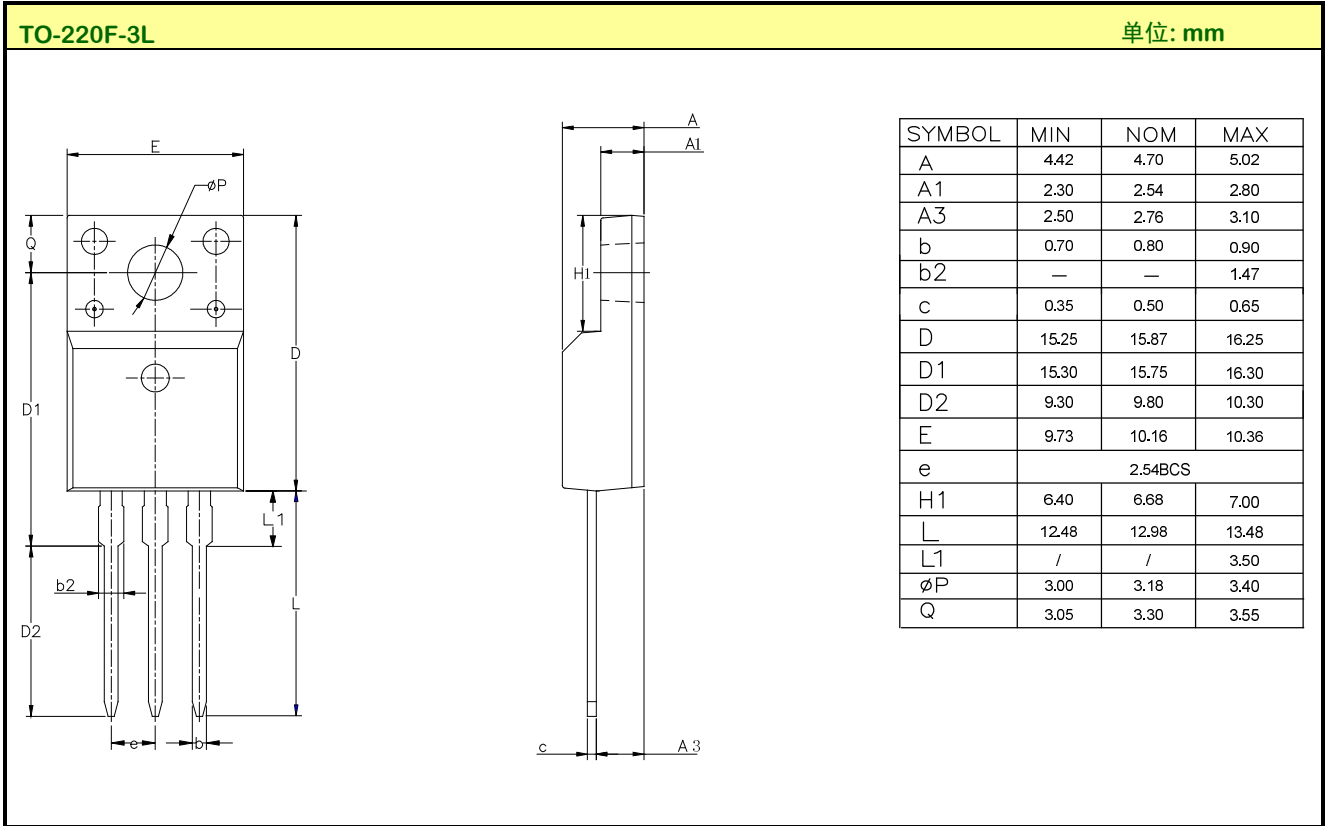
开关时间测试电路及波形图



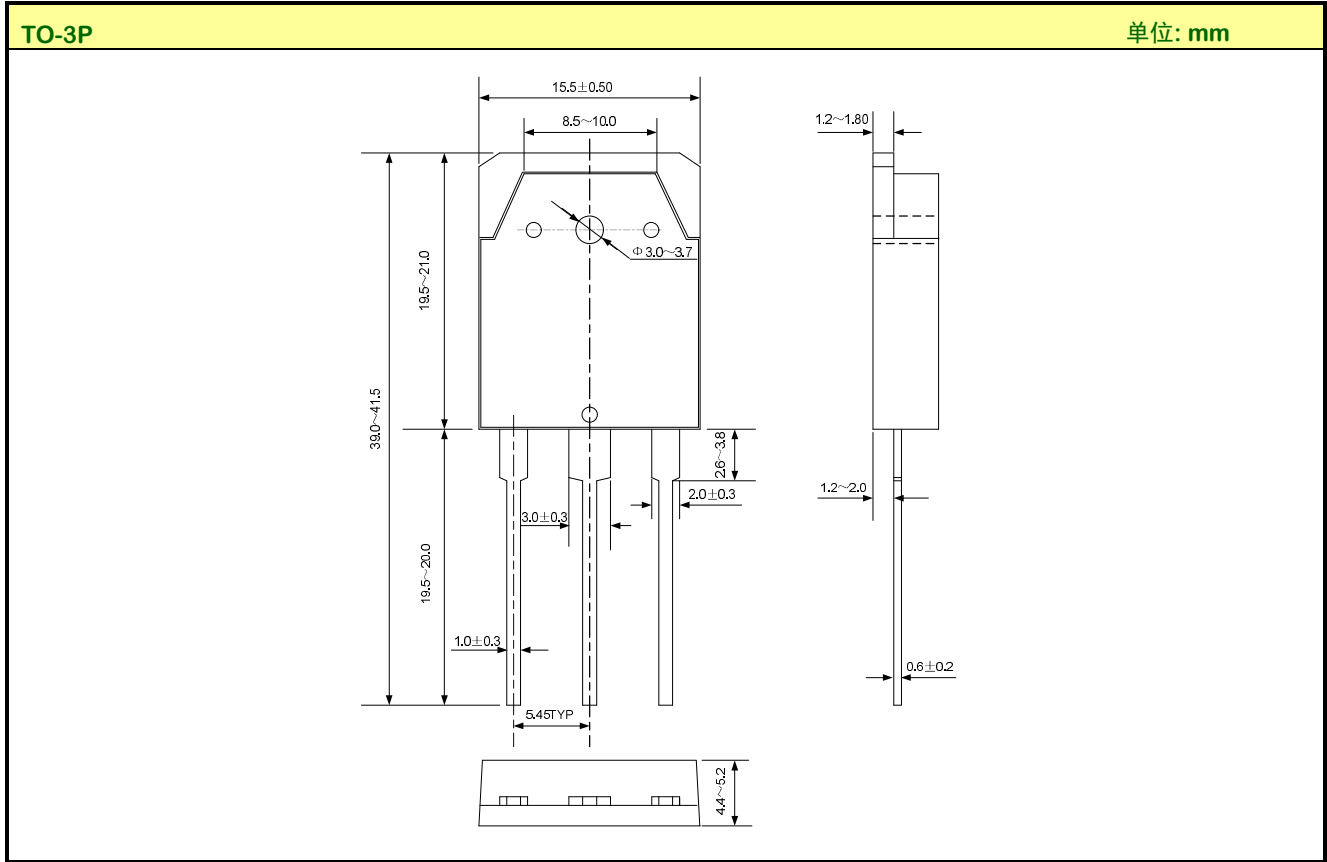
EAS测试电路及波形图



封装外形图



封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称: SVF18N65F/T/PN 文档类型: 说明书
版 权: 杭州士兰微电子股份有限公司 公司主页: <http://www.silan.com.cn>

版 本: 1.4

修改记录:

1. 增加 TO-220-3L 封装南通和集佳外形信息
-

版 本: 1.3

修改记录:

1. 修改 TO-220F-3L 封装信息
 2. 修改 TO-220-3L 封装信息
 3. 增加 TO-3P 封装
-

版 本: 1.2

修改记录:

1. 增加 TO-220-3L 封装
-

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改热阻特性
-

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式发布版本
-
-